

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名:
メーカー名:
型及び銘柄:

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 1 / 3 )

次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 7- (1) 集積回路 (4の項の中欄に掲げるものを除く。)	判定欄	注釈	記入欄
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のもの、 次のいずれかに該当するものとする。	該当○ 非該当× 対象外-		
一 集積回路 (モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、 マルチチップ集積回路、膜形集積回路 (シリコンオンサファイア集積回路 を含む。)、光集積回路、三次元集積回路及び モノリシックマイクロ波集積回路を含む。) であつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
イ 次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの	[ ]		
(1) 全吸収線量がシリコン換算で5,000グレイ以上のもの	[ ]		数値 ( )
(2) 吸収線量がシリコン換算で1秒間に 5,000,000グレイ以上のもの	[ ]		数値 ( )
(3) 1メガ電子ボルト相当の中性子束 (積算値) が 1平方センチメートルあたり50兆個以上となるもの (MIS形ものを除く。)	[ ]		数値 ( ) 数値 ( )
ロ マイクロプロセッサ、 マイクロコンピュータ、 マイクロコントローラ、 化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、 アナログデジタル変換用のもの、 アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、 若しくは処理することができるもの、 デジタルアナログ変換用のもの、 信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、 フィールドプログラマブルロジックデバイス、 カスタム集積回路 (ハからチまで若しくはルからカまでのいずれかに 該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの 又は輸出令別表第1の5から15までの項の中欄の いずれかに該当する貨物に使用するように設計したもの であるかどうかの判断をすることができるものを除く。 以下この条において同じ。)、 FFTプロセッサ、 スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであつて、 次のいずれかに該当するもの (民生用の自動車又は鉄道車両用に設計した 集積回路を除く。)	[ ]		
(一) 125度を超える温度で使用することができる ように設計したもの	[ ]		数値 ( )
(二) 零下55度未満の温度で使用することができる ように設計したもの	[ ]		数値 ( )
(三) 零下55度以上125度以下の全ての温度範囲 で使用することができるように設計したもの	[ ]		数値 ( )
ハ マイクロプロセッサ、 マイクロコンピュータ 又はマイクロコントローラのうち、 化合物半導体を用いたものであつて、 最大クロック周波数が40メガヘルツを超えるもの	[ ]		数値 ( )
ニ 削除			

# 輸出貿易管理令 別表第 1 項目別対比表 (該非判定用)

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 2 / 3 )

次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 7-(1) 集積回路 (4の項の中欄に掲げるものを除く。)	判 定 欄	注 釈	記 入 欄
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	該 当 ○ 非該当 × 対象外 -		
一 集積回路（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、 マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路 を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及び モノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であつて、 次のいずれかに該当するもの			
ホ アナログデジタル変換用のもの 又はデジタルアナログ変換用のものであつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
(一) アナログデジタル変換用のものであつて、 次のいずれかに該当するもの（ワに該当するものを除く。）	[ ] 《 》	] 除外	
1 分解能が8ビット以上10ビット未満のものであつて、 サンプルレートが1.3ギガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
2 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであつて、 サンプルレートが600メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
3 分解能が12ビット以上14ビット未満のものであつて、 サンプルレートが400メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
4 分解能が14ビット以上16ビット未満のものであつて、 サンプルレートが250メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
5 分解能が16ビット以上のものであつて、 サンプルレートが65メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
(二) デジタルアナログ変換用のものであつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
1 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであつて、 調整された更新速度が 3,500メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
2 分解能が12ビット以上のものであつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		数値 ( )
一 調整された更新速度が1,250メガサンプリング毎秒を超え 3,500メガサンプリング毎秒以下のもののうち、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		数値 ( ) 数値 ( )
イ 12ビットの分解能で動作する場合のアナログ出力値が、 フルスケールのレベルからフルスケールの0.024パーセント以内の レベルに変化するまでのセトリング時間が9ナノ秒未満のもの	[ ]		数値 ( )
ロ 100メガヘルツのデジタル入力信号でフルスケールを出力する場合 又は100メガヘルツ未満のデジタル入力信号で最も高いフルスケールを 出力する場合のスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジが 68デシベルを超えるもの	[ ]		数値 ( )
二 調整された更新速度が3,500メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
ヘ 信号処理用の電気光学的集積回路 又は光集積回路であつて、 次の (一) から (三) までのすべてに該当するもの	[ ]		
(一) レーザ二発振器を有するもの	[ ]		
(二) 受光素子を有するもの	[ ]		
(三) 光導波路を有するもの	[ ]		
ト フィールドプログラマブルロジックデバイス（コンプレックス プログラマブルロジックデバイス、フィールドプロ グラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジ ックアレイ又はフィールドプログラマブル相互接続用集積 回路を含む。）であつて、次のいずれかに該当するもの (ワに該当するものを除く。)	[ ] 《 》	] 除外	
(一) シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が 700を超えるもの	[ ]		数値 ( )
(二) シリアルトランシーバーの最大データ速度の総計が 1秒当たり500ギガビット以上のもの	[ ]		数値 ( )
チ ニューラルネットワークを用いたもの	[ ]		

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 3 / 3 )

次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 7- (1) 集積回路 (4の項の中欄に掲げるものを除く。)	判定欄	注 釈	記 入 欄
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	該 当 ○ 非該当 × 対象外 -		
一 集積回路 (モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、 マルチチップ集積回路、膜形集積回路 (シリコンオンサファイア集積回路 を含む。)、光集積回路、三次元集積回路及び モノリシックマイクロ波集積回路を含む。) であつて、 次のいずれかに該当するもの			
リ カスタム集積回路であつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
(一) 端子数が1,500を超えるもの	[ ]		数値 ( )
(二) 基本ゲート伝搬遅延時間が0.02ナノ秒未満のもの	[ ]		数値 ( )
(三) 動作周波数が3ギガヘルツを超えるもの	[ ]		数値 ( )
ヌ 化合物半導体を用いたデジタル方式のものであつて、 次のいずれかに該当するもの (ハ、ホからリまで及びルの いずれかに該当するものを除く。)	[ ]	《 》	] 除外
(一) 等価ゲート数が2入力ゲート換算で3,000を超えるもの	[ ]		数値 ( )
(二) トグル周波数が1.2ギガヘルツを超えるもの	[ ]		数値 ( )
ル F F Tプロセッサであつて、高速フーリエ変換のミリ秒で表した 定格実行時間が次に掲げる式により算出した値未満のもの $\frac{\text{(複素点の数)} \times \log_2 \text{(複素点の数)}}{20,480}$	[ ]		数値 ( )
ヲ ダイレクト・デジタル・シンセサイザ (DDS) 集積回路であつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
(一) デジタルアナログ変換クロック周波数が 3.5ギガヘルツ以上であつて、 デジタルアナログ変換分解能が 10ビット以上12ビット未満のもの	[ ]		数値 ( ) 数値 ( )
(二) デジタルアナログ変換クロック周波数が 1.25ギガヘルツ以上であつて、 デジタルアナログ変換分解能が12ビット以上のもの	[ ]		数値 ( )
ワ 次の (一) 及び (二) に該当するもの又はこれを実行するように プログラムが可能なもの	[ ]		
(一) アナログデジタル変換機能を有するものであつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
1 分解能が8ビット以上10ビット未満のものであつて、 サンプルレートが1.3ギガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
2 分解能が10ビット以上12ビット未満のものであつて、 サンプルレートが1ギガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
3 分解能が12ビット以上14ビット未満のものであつて、 サンプルレートが1ギガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
4 分解能が14ビット以上16ビット未満のものであつて、 サンプルレートが400メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
5 分解能が16ビット以上のものであつて、 サンプルレートが180メガサンプリング毎秒を超えるもの	[ ]		数値 ( )
(二) 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
1 デジタル化されたデータを記録するもの	[ ]		数値 ( )
2 デジタル化されたデータを処理するもの	[ ]		数値 ( )
カ 相補型金属酸化膜半導体集積回路であつて、零下268.65度以下の温度で作動 するように設計したもの (ロに該当するものを除く。)	《 》	] 除外	数値 ( )

作成責任者： (作成年月日： 年 月 日)

会 社 名 \_\_\_\_\_

所 属 ・ 役 職 \_\_\_\_\_

(フリガナ)  
氏 名 \_\_\_\_\_ 印

電 話 \_\_\_\_\_

判定結果	<input type="checkbox"/> 該当	<input type="checkbox"/> 非該当
該当項番		
① 輸出令別表第1の項番 [ ]		
② 貨物等省令の条項号等の番号等 [ ]		





# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名:
メーカー名:
型及び銘柄:

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 1 / 1 )

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 7-(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	判定欄	注釈	記入欄
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	該当 ○ 非該当 × 対象外 -		
十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品 (次号に該当するものを除く。)	[ ]	] 除外	
ヲ ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式 又はステップアンドスキャン方式の露光装置であつて、 光学方式のものであり、かつ、光源の波長が193ナノメートル 以上のものうち、次の(一)及び(二)に該当するもの (ハ(一)2に該当するものを除く。)	[ ]		数値 ( )
(一) ナノメートルで表した光源の波長に0.25を乗じて得た数値を 開口数の値で除して得た数値が4.5以下のもの	[ ]		数値 ( )
(二) 同一装置による重ね合わせ精度の 最大値が2.4ナノメートル以下のもの	[ ]		数値 ( )
判定結果		□該当 □非該当	
該当項番		① 輸出令別表第1の項番 [ ] ② 貨物等省令の条項号等の番号等 [ ]	

作成責任者: (作成年月日: 年 月 日)

会社名 \_\_\_\_\_

所属・役職 \_\_\_\_\_

(フリガナ)

氏名 \_\_\_\_\_ 印

電話 \_\_\_\_\_

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名:
メーカー名:
型及び銘柄:

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 1 / 2 )

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの	判定欄	注釈	記入欄
7-(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	該当○ 非該当× 対象外-		
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	【 〇 】		
十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品(次号に該当するものを除く。)	《 》	] 除外	
レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であつて、 次のいずれかに該当するもの	[ ]		
(一) 電気メッキ又は無電解メッキによりコバルトを成膜するように設計したもの	[ ]		
(二) 化学的気相成長法によりコバルトを充填するように設計したもの又は選択性のボトムアップ成膜を用いる化学的気相成長法によりタングステンを充填するように設計したもの	[ ]		
(三) 単一のチャンバー内での複数の工程によって 金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置であつて、 次の全てに該当するもの(二)に該当するものを除く。)	《 》	] 除外	
1 ウエハーの基板温度を100度超500度未満に維持しながら、 有機金属化合物を用いてタングステンの層を成膜するもの	[ ]		数値( )
2 水素(水素と窒素又はアンモニアとの混合物を含む。) を用いたプラズマによる工程を有するもの	[ ]		数値( )
(四) 半導体製造装置であつて、複数のチャンバー 又はステーション内での複数の工程によって成膜するものであり、 かつ、複数の工程間において0.01パスカル以下の真空状態 又は不活性の環境を維持することができるように設計したもの (以下「特定半導体製造装置」という。)のうち、 次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように 設計したもの(二)に該当するものを除く。)	《 》	] 除外	
1 ウエハーの基板温度を100度超500度未満に維持しながら、 水素(水素と窒素又はアンモニアとの混合物を含む。) を用いたプラズマにより表面処理を行う工程	[ ]		数値( )
2 ウエハーの基板温度を40度超500度未満に維持しながら、 酸素又はオゾンを用いたプラズマにより表面処理を行う工程	[ ]		数値( )
3 ウエハーの基板温度を100度超500度未満に維持しながら、 タングステンの層を成膜する工程	[ ]		数値( )
(五) 特定半導体製造装置のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの(二)に該当するものを除く。)	《 》	] 除外	
1 リモートプラズマ源及びイオンフィルターを用いて表面処理を行う工程	[ ]		
2 有機金属化合物を用いて銅の上に選択的にコバルトの層を成膜する工程	[ ]		
(六) 仕事関数金属(トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。 以下同じ。)を原子層堆積法により成膜するように設計した装置であつて、 次の全てに該当するもの	[ ]		
1 2以上の金属の供給源を有するもののうち、 アルミニウムの前駆体用に設計した供給源を1以上有するもの	[ ]		数値( )
2 30度超の温度で作動するように設計した前駆体容器を有するもの	[ ]		数値( )
3 仕事関数金属を成膜するように設計した装置であつて、 次の全てに該当するもの	[ ]		
一 炭化チタンアルミニウムを成膜するもの	[ ]		
二 4.0電子ボルト超の仕事関数を可能とするもの	[ ]		数値( )

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 2 / 2 )

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 7- (16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	判定欄	注 釈	記 入 欄
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	該 当 ○ 非該当 × 対象外 -		
十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品(次号に該当するものを除く。)	[ ]		
レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であつて、 次のいずれかに該当するもの			
(七) 特定半導体製造装置のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を 成膜するように設計したもの(二)に該当するものを除く。)	[ ] 《 》	] 除外	
1 ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、 有機金属化合物を用いて窒化チタン又は炭化タングステンの層 を成膜する工程	[ ]		数値 ( ) 数値 ( )
2 ウエハーの基板温度を500度未満に維持しながら、0.1333パスカル超 13.33パスカル未満の圧力でスパッタリング法によりコバルトの層 を成膜する工程	[ ]		数値 ( ) 数値 ( )
3 ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、 133.3パスカル超13.33キロパスカル未満の圧力で 有機金属化合物を用いてコバルトの層を成膜する工程	[ ]		数値 ( ) 数値 ( ) 数値 ( )
(八) 特定半導体製造装置のうち、次に掲げる全ての工程により銅配線を形成する ように設計したもの(二)に該当するものを除く。)	[ ] 《 》	] 除外	
1 ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、 133.3パスカル超13.33キロパスカル未満の圧力で 有機金属化合物を用いてコバルト又はルテニウムの層を成膜する工程	[ ]		数値 ( ) 数値 ( )
2 ウエハーの基板温度を500度未満に維持しながら、0.1333パスカル超 13.33パスカル未満の圧力で 物理的气相成長法を用いて銅の層を成膜する工程	[ ]		数値 ( ) 数値 ( ) 数値 ( )
(九) 有機金属化合物を用いてバリアー膜又はライナーを選択的に成膜するように 設計した原子層堆積装置	[ ]		
(十) ウエハーの基板温度を500度未満に維持しながら、配線の全体又は絶縁膜と絶縁膜との 隙間(幅が40ナノメートル未満のものに限る。)にタングステンを 原子層堆積法により充填するように設計したもの (二)に該当するものを除く。)	[ ] 《 》	] 除外	数値 ( ) 数値 ( ) 数値 ( )
判定結果		<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	
作成責任者：(作成年月日： 年 月 日)		該当項番	
会社名 _____	① 輸出令別表第1の項番 [ _____ ]		
所属・役職 _____	② 貨物等省令の条項号等の番号等		
(フリガナ) _____	[ _____ ]		
氏 名 _____ 印	[ _____ ]		
電 話 _____			



# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名:
メーカー名:
型及び銘柄:

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 1 / 1 )

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 7-(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	判定欄	注釈	記入欄
<p>[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。</p> <p>十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品(次号に該当するものを除く。)</p> <p>ラ 成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) ウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を 促進させることで成膜するものであつて、シリコン及び炭素を含み、かつ、 比誘電率が5.3未満の膜を、幅が70ナノメートル未満であり、当該幅に 対する深さの比率が5倍を超え、かつ、パターンピッチが100ナノメートル 未満である水平方向の開口部に成膜するように設計したもの</p> <p>(二) 400度超650度未満の温度で成膜するもの(シリコン及び炭素を含み、かつ、 比誘電率が5.3未満の膜を、幅が70ナノメートル未満であり、当該幅に 対する深さの比率が5倍を超え、かつ、パターンピッチが100ナノメートル 未満である水平方向の開口部に成膜するように設計したものに限る。)であつて、 次の全てに該当するもの(一)に該当するものを除く。)</p> <p>1 垂直方向に積み重なった複数のウエハーを保持するように設計されたポートを 有するもの</p> <p>2 2以上の垂直方向に伸びるインジェクターを有するもの</p> <p>3 膜のシリコン原料及びプロペンが導入されるインジェクターと膜の窒素原料 又は膜の酸素原料が導入されるインジェクターが異なるもの</p>	該当 ○ 非該当 × 対象外 -  【 】  《 》 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	] 除外          ] 除外	数値 ( ) 数値 ( )       数値 ( ) 数値 ( )    数値 ( )
		判定結果	□該当 □非該当

作成責任者: (作成年月日: 年 月 日)

会社名 \_\_\_\_\_

所属・役職 \_\_\_\_\_

(フリガナ)  
氏名 \_\_\_\_\_ 印

電話 \_\_\_\_\_

該当項番 ① 輸出令別表第1の項番 [ ] ② 貨物等省令の条項号等の番号等 [ ] [ ]
--

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名:
メーカー名:
型及び銘柄:

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 1/1 )

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 7-(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	判定欄	注釈	記入欄
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。 十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品(次号に該当するものを除く。) キ 厚さが100ナノメートル超であり、かつ、応力が450メガパスカル未満のカーボン ハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置	該当 ○ 非該当 × 対象外 - 【 】 《 》 [ ]	除外	数値 ( ) 数値 ( )
判定結果		□該当 □非該当	
該当項番		① 輸出令別表第1の項番 [ ] ② 貨物等省令の条項号等の番号等 [ ] [ ]	

作成責任者: (作成年月日: 年 月 日)

会社名 \_\_\_\_\_

所属・役職 \_\_\_\_\_

(フリガナ)  
氏名 \_\_\_\_\_ 印

電話 \_\_\_\_\_

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名:
メーカー名:
型及び銘柄:

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 1 / 1 )

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 7- (16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	判定欄	注釈	記入欄
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	該当 ○ 非該当 × 対象外 -		
十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。) 若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品 (次号に該当するものを除く。)	{ }	] 除外	
オ 金属配線間の隙間 (幅が2.5ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さ の比率が1倍以上のものに限る。) に比誘電率が3.3未満の低誘電層を空隙が生じないように プラズマを用いて成膜するように設計した装置	《 》 [ ]		数値 ( ) 数値 ( ) 数値 ( ) 数値 ( )
判定結果		□該当 □非該当	
該当項番 ① 輸出令別表第1の項番 [ ] ② 貨物等省令の条項号等の番号等 [ ] [ ]			

作成責任者: (作成年月日: 年 月 日)

会社名 \_\_\_\_\_

所属・役職 \_\_\_\_\_

(フリガナ)

氏名 \_\_\_\_\_ 印

電話 \_\_\_\_\_

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

貨物名:
メーカー名:
型及び銘柄:

©CISTEC

2024.09.08施行省令等対応 ( 1 / 1 )

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの	判定欄	注釈	記入欄
7-(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	該当 ○ 非該当 × 対象外 -		
[省令] 第6条 輸出令別表第1の7の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	[ ]		
十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置 (ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、 次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 若しくは附属品(次号に該当するものを除く。)	《 》 [ ]	] 除外	数値 ( )
ヤ 0.01パスカル以下の真空状態において、高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、 かつ、銅の成膜を可能にするように設計した洗浄除去装置	[ ]		

作成責任者: (作成年月日: 年 月 日)

会社名 \_\_\_\_\_

所属・役職 \_\_\_\_\_

(フリガナ)

氏名 \_\_\_\_\_ 印

電話 \_\_\_\_\_

判定結果	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当
該当項番	
① 輸出令別表第1の項番 [ ]	
② 貨物等省令の条項号等の番号等 [ ]	
[ ]	



